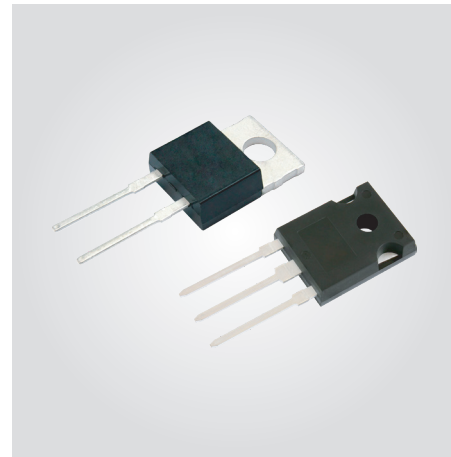




The DNA of tech.™

650 V 碳化硅肖特基二极管 提高高频应用的效率

采用 MPS 设计，4 A 至 40 A 的器件可减少开关损耗和温度变化的影响。



产品优势

- 采用合并 PIN 肖特基 (MPS) 的设计
- 可提供 4 A 至 40 A 的额定电流
- 在 SiC 宽带隙材料上使用肖特基技术的多数载流子二极管
- 导通压降符合正温度系数，易于并联
- 几乎没有反向恢复时间和开关损耗
- 提供 2L TO-220AC 和 TO-247AD 3L 封装
- 可在高达 +175 °C 温度下运行
- 符合 RoHS 标准且不含卤素

市场应用

- PFC，高压电源的高频整流，LLC 转换器，服务器电源，通信电源，UPS 以及太阳能逆变器

样品

- 可提供样品和量产，大订单的交货期为十周

资料来源

- 数据表：请参见下一页，了解现在采用 2L TO-220AC 和 TO-247AD 3L 封装的新型 650 V 碳化硅肖特基二极管的列表
- 如有技术问题，请联系：
DiodesAmericas@vishay.com,
DiodesEurope@vishay.com 和
DiodesAsia@vishay.com
- 材料分类：
有关合规性的定义，请参见
www.vishay.com/doc?99912



The DNA of tech.™

主要规格

- 采用 2L TO-220AC 和 TO-247AD 3L 封装的 650 V 碳化硅肖特基二极管

零件编号	$I_{F(AV)}$ (A)	V_{RRM} (V)	25 °C 时的 I_{FSM} , 10 ms (A)	I_F 和 T_J 下的			T_J 最大值 (°C)	封装工艺	是否通过 AEC-Q101
				V_F (V)	I_F (A)	T_J (°C)			
VS-C04ET07T-M3	4	650	26	1.75	4	150	175	2L TO-220AC	否
VS-C06ET07T-M3	6	650	39	1.7	6	150	175	2L TO-220AC	否
VS-C08ET07T-M3	8	650	57	1.7	8	150	175	2L TO-220AC	否
VS-C10ET07T-M3	10	650	68	1.75	10	150	175	2L TO-220AC	否
VS-C12ET07T-M3	12	650	80	1.65	12	150	175	2L TO-220AC	否
VS-C16ET07T-M3	16	650	120	1.65	16	150	175	2L TO-220AC	否
VS-C20ET07T-M3	20	650	160	1.6	20	150	175	2L TO-220AC	否
VS-C16CP07L-M3	16	650	53	1.7	8	150	175	TO-247AD 3L	否
VS-C20CP07L-M3	20	650	64	1.75	10	150	175	TO-247AD 3L	否
VS-C40CP07L-M3	40	650	160	1.55	20	150	175	TO-247AD 3L	否

点击零件编号，可以访问产品的数据表、3D 模型、库存情况以及其它信息。